



Transistor NPN de Potencia RF / 470 MHz / 6.2 dB Ganancia / 25 W / 16 VCEO / 103 W Disipación

SKU: MRF644 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$736.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 1.4rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Transistor NPN de Potencia RF para Aplicaciones de 470 MHz</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'>Este transistor NPN de potencia RF está diseñado para operar eficientemente en la banda de 470 MHz, ofreciendo una ganancia de 6.2 dB y una potencia de salida de 25 watt. Fabricado con tecnología de silicio avanzada, proporciona impedancia controlada tanto en entrada como en salida, facilitando el diseño de etapas amplificadoras sin necesidad de redes de adaptación complejas. Su arquitectura térmica optimizada permite manejar elevadas densidades de potencia en aplicaciones de transmisión de RF, broadcast y telecomunicaciones profesionales.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El dispositivo incorpora especificaciones eléctricas robustas que garantizan operación estable bajo condiciones de carga variables, con voltajes de ruptura conservadores que proporcionan margen de seguridad en diseños de alta fiabilidad para infraestructura crítica de comunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; margin: 20px 0 12px; font-size: 1.1rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Tecnología de silicio avanzada para máxima eficienciaImpedancia de entrada y salida controladaAlta ganancia de potencia: 6.2 dB a 470 MHzDisipación térmica de 103 W con derating de 0.59 W/°CResistencia térmica juntura-carcaza de 1.7 °C/WRango de temperatura de almacenamiento: -65°C a +150°C<h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px; font-size: 1.1rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Parámetros de RF</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia de operación470 MHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia de salida25 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ganancia de potencia6.2 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia de salida25 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>VCEO (Voltaje colector-emisor)16 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>VCBO (Voltaje colector-base)36 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>VEBO (Voltaje emisor-base)4.0 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corriente de colector (IC)4.0 ADC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Disipación total (TC=25°C)103 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia térmica (RθJC)1.7 °C/W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Derating sobre 25°C0.59 W/°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango temperatura almacenamiento-65 a +150 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Características Eléctricas (TC=25°C)</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>V(BR)CEO (IC=20 mADC, IB=0)16 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>V(BR)CBO (IC=20 mADC, VBE=0)36 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>V(BR)EBO (IE=5.0 mADC, IC=0)4.0 VDC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corriente fuga colector (VCE=15 VDC)≤5.0 mADC</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Silicio avanzado para alta eficiencia térmica
Característica 2	Impedancia controlada entrada y salida
Característica 3	Disipación de 103 W a 25°C con derating
Característica 4	Resistencia térmica baja de 1.7°C/W
Característica 5	Rango operativo -65°C a +150°C
Característica 6	Ruptura colector-base de 36 VDC